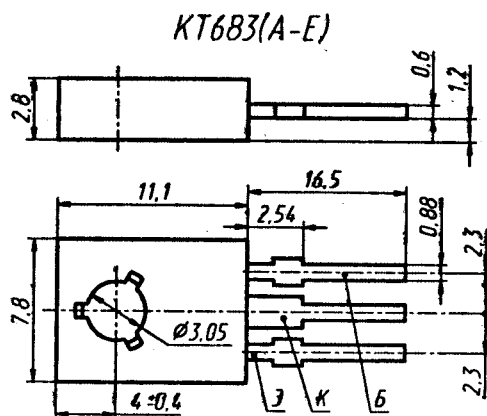


## КТ683А, КТ683Б, КТ683В, КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е

Транзисторы кремниевые планарные структуры *n-p-n* универсальные. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 1 г.

Изготовитель — акционерное общество «Кремний», г. Брянск.



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{кз} = 10$  В,  $I_k = 0,15$  А:

КТ683А, КТ683В, КТ683Г ..... 40...120

КТ683Б, КТ683Д ..... 80...240

КТ683Е ..... 160...480

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{кб} = 10$  В,  $I_3 = 50$  мА, не менее ..... 50 МГц

Граничное напряжение при  $I_3 = 30$  мА, не менее:

КТ683А ..... 90 В

КТ683Б, КТ683В ..... 80 В

КТ683Г ..... 60 В

КТ683Д, КТ683Е ..... 40 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при  $I_k = 0,15$  А,  $I_б = 15$  мА, не более ..... 0,45 В

Напряжение насыщения база—эмиттер при  $I_k = 0,15$  А,  $I_б = 15$  мА, не более ..... 1 В

Пробивное напряжение коллектор—эмиттер при  $I_k = 0,1$  мА,  $R_{бз} = 3$  кОм, не менее:

КТ683А ..... 150 В

КТ683Б, КТ683В ..... 120 В

КТ683Г ..... 100 В

КТ683Д, КТ683Е ..... 60 В

Пробивное напряжение база—эмиттер при  $I_3 = 0,1$  мА, не менее:

КТ683А, КТ683Б, КТ683В ..... 7 В

КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е ..... 5 В

Время включения при  $U_{кз} = 40$  В,  $I_k = 0,2$  А,  $I_б = 40$  мА, типовое значение ..... 0,1\* мкс

Время выключения при  $U_{кз} = 40$  В,  $I_k = 0,2$  А,  $I_б = 40$  мА, типовое значение ..... 0,2\* мкс

Емкость коллекторного перехода при  $U_{кб} = 10$  В, не более ..... 15\* пФ

Емкость эмиттерного перехода при  $U_{эб} = 0,5$  В, не более ..... 65\* пФ

Обратный ток коллектора при  $U_{кб} = 90$  В для КТ683А, КТ683Б, КТ683В и 40 В для КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е, не более ..... 1 мкА

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:

КТ683А .....	150 В
КТ683Б, КТ683В .....	120 В
КТ683Г .....	100 В
КТ683Д, КТ683Е .....	60 В

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер:

при  $R_{БЭ} = 3 \text{ кОм}$ :

КТ683А .....	150 В
КТ683Б, КТ683В .....	120 В
КТ683Г .....	100 В
КТ683Д, КТ683Е .....	60 В

при  $R_{БЭ} = \infty$ :

КТ683А .....	90 В
КТ683Б, КТ683В .....	80 В
КТ683Г .....	60 В
КТ683Д, КТ683Е .....	40 В

Постоянное напряжение база—эмиттер:

КТ683А, КТ683Б, КТ683В .....	7 В
КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е .....	5 В

Постоянный ток коллектора .....

1 А

Импульсный ток коллектора при  $t_n = 1 \text{ мс}$  .....

2 А

Постоянный ток базы .....

0,2 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора<sup>1</sup> при  $T_K = -60...+25 \text{ }^\circ\text{C}$ :

с теплоотводом .....

8 Вт

без теплоотвода .....

1,2 Вт

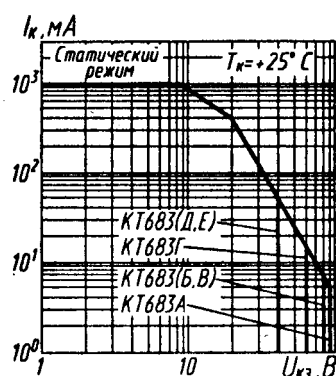
Температура  $p$ - $n$  перехода .....

+150  $^\circ\text{C}$

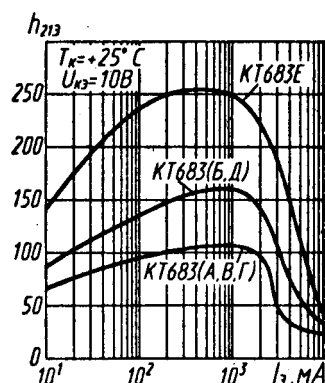
Температура окружающей среды .....

-60...  $T_K =$   
= +125  $^\circ\text{C}$

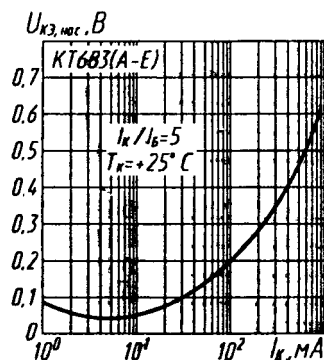
<sup>1</sup> При  $T_K \geq 25 \text{ }^\circ\text{C}$   $P_{K, \text{макс}}$  снижается линейно на 0,064 Вт/ $^\circ\text{C}$  с теплоотводом и на 0,0096 Вт/ $^\circ\text{C}$  без теплоотвода.



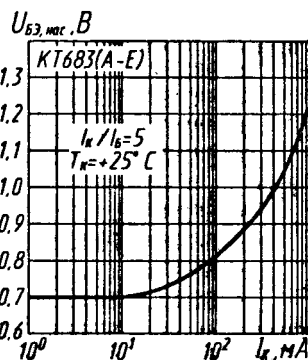
Области безопасной работы транзисторов



Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база—эмиттер от тока коллектора